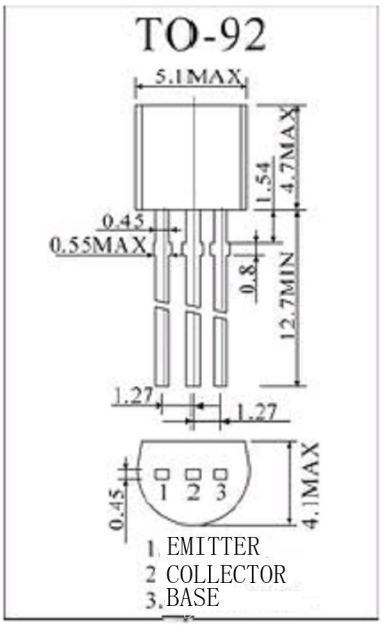
DAYA
臺源國際股份有限公司

TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors

S8050

—NPN silicon—

■■主要用途：功率放大、开关等。



■■绝对最大额定值（Ta=25℃）

项　　目	符　号	额定值	单　位
集电极—基极电压	V_{CBO}	40	V
集电极—发射极电压	V_{CEO}	25	V
发射极—基极电压	V_{EBO}	6	V
集电极电流	I_C	1.5	A
集电极耗散功率	P_C	1	W
结　　温	T_J	150	℃
存储温度	Tstg	-55~150	℃

■■电参数（Ta=25℃）

项　　目	符　号	最小值	典型值	最大值	单位	测　试　条　件
直流电流增益	h_{FE}	85		300		V_{CE}= 1 V，I_C= 100 mA
集电极-基极截止电流	I_{CBO}			0.1	μA	V_{CB}= 35 V，I_E=0
发射极-基极截止电流	I_{EBO}			0.1	μA	V_{EB}= 6 V，I_C=0
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	40			V	I_C= 0.1 mA，I_E=0
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	25			V	I_C= 2 mA，I_B=0
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	6			V	I_B= 0.1 mA，I_C=0
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$		0.28	0.5	V	I_C= 800 mA，I_B= 80 mA
基极-发射极饱和压降	$V_{BE(sat)}$		0.98	1.2	V	I_C= 800 mA，I_B= 80 mA
电流增益-带宽乘积	f_T	100			MHz	I_C= 50 mA，V_{CE}= 10 V
共基极输出电容	Cob		9	20	PF	V_{CB}= 10 V，I_E=0，f = 1 MHz

■■h_{FE} 分档及其标志

分档	B	C	D
h_{FE}	85~160	120~200	160~300